

## **S O M M A I R E**

### **des Communications plénières\***

#### **MÉCANISMES FONDAMENTAUX**

- Comparaison de quelques mécanismes fondamentaux en pulvérisation sous décharge en CVD plasma (PECVD)  
B. GROLLEAU 1

#### **DIAGNOSTIC DANS LES PLASMAS**

- Derniers développements sur le diagnostic dans les plasmas  
A. RICARD 39

#### **PROCÉDÉS ET TECHNOLOGIE**

- La dualité des phénomènes gravure et dépôts en plasma  
R. D'AGOSTINO - P. CAPEZZUTO 73

#### **PROCÉDÉS ET PRODUITS**

- La passivation des défauts dans le silicium par l'hydrogène atomique  
J.I. PANKOVE 119
- Croissance et structure des semiconducteurs amorphes  
B. ABELES 155

#### **PRODUITS ET APPLICATIONS**

- Le silicium amorphe : de la physique du matériau aux applications  
A. CHENEVAS-PAULE 179

#### **PROCÉDÉS ET CARACTÉRISATION**

- Les systèmes diélectriques - InP  
P. VIKTOROVITCH 213

#### **ÉQUIPEMENT ET ENVIRONNEMENT**

- Évolution générale des techniques plasma et des équipements associés  
D. PRUD'HOMME 271
- Contrôle et transfert de gaz purs utilisés en électronique  
T. GOVERS 301